# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平9-321021

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	徽別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/3065			H 0 1 L 21/302	G
C 2 3 F 4/00			C 2 3 F 4/00	Z

## 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

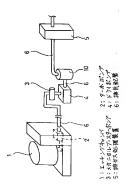
(21)出願番号	特臘平8-129869	(71)出職人 000001889
		三洋電機株式会社
(22) 出順日	平成8年(1996)5月24日	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者 天施 孝
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
		洋電機株式会社内
		(72)発明者 丸山 朋彦
		11.00
		新潟県小千谷市千谷甲3000番地 新潟三洋 電子株式会社内
		(72) 発明者 新保 正一
		新潟県小千谷市千谷甲3000番地 新潟三洋
		電子株式会社内
		(74)代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)
		最終頁に続く
		观除具に続く

#### (54) 【発明の名称】 ドライエッチング装置

### (57)【要約】

【課題】 排気配管内での反応性生成物の維積を防止す ることで、ドライポンプの停止を防止し、製品不良の発 生を防止すると共に、メンテナンス作業の簡便化を図

【解決手段】 ドライボンプ4から排ガス処理装置5間 につながる排気配管6の途中にアルミニウム・エッチン グ時に生成される少なくともホウ素を主成分とする反応 性生成物を回収するトラップ装置10を設け、前記ドラ イボンプ4側の排気配管6から当該トラップ装置10に 供給された排ガスを該トラップ装置の冷却システムによ り所定温度以下に下げた状態で排ガス処理装置5側の排 気配管6へ排出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 エッチングチャンバと該エッナングチャンバを所定の真空度まで減圧する真空ボンフと該真空ボンフと該真空ボンアンがら解集会れる排ガスを処理する排ガス処理装置とから成り、半導体ウエハにアルミニウム・エッチング処理を施すドライエッチング製置において、前記真空ボフルら前記排力及処理装置にこつなるが表面管での所望位置にアルミニウム・エッチング時に生成される反応性生成物を収収する回収接置を設けたことを特徴とするドライエッチング芸術。

1

【請求項2】 前記回収装版は、前記期収配深の途中に 配置され、前記真空ボンフ側の併気配管から当該回収装 置に供給さたた排がえを該回収装置から出端の で循環させながら該回収装置か外局部に巻を付けた配管 成以下に下げた状態で排が水塊埋装置側の排気配管へ排 出するようにしたことを特徴とする請求項第1項記載の ドライエッサング装置。

【請求項3】 前記反応性生成物は、少なくともホウ素 を主成分とする生成物であることを特徴とする請求項第 20 1 項記載のドライエッチング装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハ等に アルミコウム・エッチングを能すドライエッチング装置 に関し、特に重定ポンアから、排方入処理装置配こなが る排気配管内にアルミニウム・エッチング時に生成され る反応性生成物が境積し、排気配管が開塞することによ りまポンアが停止し、エッチング作業性が劣化する ことを防止する技術に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、この種のドライエッチング装置、 特に出すス処理システムは、図5に示すようにエッチング サイナンバ51 内の所定位置に関示してい半導体ウエハ をセットした後に、ターボボンブ52、メカニカルブー スターボンブ53及びドライボンブ54から成る資金ボ ンプで、チャンパ質を至りに大規定で、エッチングチャ ンバ51の図示しないエッチングガス供給部から例えば 三塩化中か素(BC13)等の反応ガスを供給すること で、半導体ウエルに所型パターのアルミニウム・エッ 40 チングを継す。そして、このときドライボンブ54から 排出される排ガスを乾式の排力、双処理装置55で浄化し た後、排気している。56は前は、マナングチャンバ5 1、ターボボンブ52、メカニカルブースターボンブ5 3、ドライボンブ54、排力ス処理装置35等をつなぐ 非知常でかるか。

# [0003]

【発明分解決しようとする課題】前途したようにドライ ボンア54から排出された排ガスが排気配管56を通っ で排ガス処理装置55に供給される間で、ドライボンブ 50 気配管から当該回収装置と供給された嫌ガスを鎮回収装

5 4で約7 0°Cの高温となった排方なが当該排取国際5 6内で徐々に冷やされて約2 5°C債まで温度が下がる間 に、該排気配管5 6内にアルミニウム・エッチング時に 生成された少なくともボウ素を主成分とする反応性生成 物が維積してしまい、該排気配管5 6 が閉塞し、排気が 続ける水でに附圧が上がり、ドライボンブラ 4 が実常停 止じてしまうことがあった。そして、それに伴ってドラ イエッチング基配の設備や上が起こり、エッチングチャン ンバ5 1 内の真空状態が解除され、エッチングチャンバ 10 5 1 内が大気に触れるため、座埃が入り込み、製品不良 が発生していた。

2

【0004】ここで、前達したホウ素を主成分とする反 応生成物の発生メカニズムは、アルミニウム・エッチン 化際して使用する三塩化中等。【BC13)とアルミ ニウムとが反応してできる塩化アルミニウムの性質とし て、水分を吸かすることにより加水分解を起こすと共 に、前尾三塩化ウ素の体質として、塩化か素のホウ 素原子は、遊館電子対を持つ分子と結合し易いというこ とで、少なくともホウ素を主成分とする反応性生成物が できると考えられる。

【0005】そして、エッチングチャンバ51からドラ イボンブ54間は、電に真空であるため、水分等がなく 仮応生成物は維備できなりが、前匙ドライボンブ54か ら排ガス処理装置55間につながれた排気記管56内で 排ガス処理共電が55間につながれた排気記管56内で 水力が提生するため、装料欠配管56内で反応生成 物が維積すると考えられる。 横、約70℃から約30 の範囲かで反応性生成物の堆積が発生しており、消失配 管56の洗浄値前が広くなり、メンテナンスが火変であ

30 った。また、因うでは使煙的にドライエッチング装置と 排ガス処理装置とを同一紙面上で図示してあるが、工場 等での実際の配置では、例えば2階のフロアによったルデー スターボンブ53、ドライボンブ54、排ガス処理装置 55を配置し、各装置能と排気配管56でつないでいる 場合が多く、このような場合、1階のフロアに配置され る各装置、特に排気配管56はグウンブローの順があた ることで、冷やされ、水分が発生する要因の一つとなっ

0 【0006】経って、本発明は排気配管内での反応性生 成物の堆積を防止することで、ドライボンブの停止を防 止し、製品不良の発生を防止すると共に、メンテナンス 作業の簡便化を図ることを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明のドライ エッチング装置は、真空ボンブから排ガス処理装置間に つながる構気配管の途中にアルミニウム・エッチング時 に生成される少なくともホケッ素を主成分とうる反応性生 成物を回収する回収装置を設け、前記真空ボンブ側の排 で展開かると変なりませない。 3

置内を循環させながら該回収装置の外周部に巻き付けた 配管内に冷却水を循環させてなる冷却システムにより所 定温度以下に下げた状態で排ガス処理装置側の排気配管 へ排出するようにしたものである。

## [00008]

【 
春明の実施の形態】以下、本発明のドライエッチング 装置、特に排ガス処理システムの一実施の形態について 図1万至図4を基に説明する。図1において、1はドラ イエッチング装置のエッチングチャンバで、該エッチン グチャンバ1内の所定位置に図示しない半導体ウエハを 10 ラップ装置10内に反応性生成物を回収するようにし、 セットした後に、ターボボンプ2、メカニカルブースタ ーポンプ3及びドライボンプ4から成る真空ボンプで、 チャンバ真空を引いた状態で、エッチングチャンバ1の 図示しないエッチングガス供給部から例えば三塩化ホウ 素(BC13)等の反応ガスを供給することで、半導体 ウエハに所望パターンのアルミニウム・エッチングを練

す。 【0009】そして、このときドライボンブ4から排出 される排ガスを鼓式の排ガス処理装置うで浄化した後、 排気する。ここまでは、従来のドライエッチング装置の 20 狭いスペースで、冷却効果、堆積効果の向上が図れる。 排ガス処理システムと同構成である。以下、本発明の特 徴である、図1に示すように前記ドライボンブ4から前 記排ガス処理装置5間につながれた排気配管6の途中に 配置され、アルミニウム・エッチング時に生成される少 なくともホウ素を主成分とする反応生成物を回収する回 収装置としてのトラップ装置10について説明する。 【0010】図2及び図3は当該トラップ装置10の斜 **視図及び断面図で、前記ドライボンブ4側につながる排** 気配管6が当該トラップ装置10の上部に設けた吸気口 11につなげられ、該排気配管6から供給された排ガス 30 分洗浄が可能となり、更に作業性が向上する。 は、排気口12の外周部に形成した仕切り板13を介し て図中矢印に示す方向に該トラップ装置10内を循環さ せられて該トラップ装置10のタンク14下方に移動す る際に、タンク14の外周部に巻き付けた配管15内に 冷却水を循環させてなる冷却システムにより所定温度 (例えば約30℃) 以下に下げられ、該排ガス内の反応 件生成物は該トラップ装置10内に堆積されると共に、 排ガスは排気口12につながれた排気配管6を通って排 ガス処理装置5個へ排出される。尚、本実施の形態で ク14内で循環するようにして、該排ガスがタンク14 内に取り付けられたシールド板17(図4参照)の側壁

は、図2に示すように仕切り板13により排ガスをタン 40 部や該仕切り板13に接する面積を多くすることで、冷 却効果、堆積効果の向上を図っている。また、冷却用の 配管15をタンク14の比較的下方位置に設けたこと で、吸気口11及び排気口12の反応性生成物が堆積し ないように設定されている。

【0011】このように、トラップ装置10内で排ガス の温度を約30℃位まで下げているため、前記反応生成 物は、該トラップ装置10内にすべて回収され、排気配 50 防止できる。

管6内には堆積されない。また、図4に示すように前記 トラップ装置10は、前記排気管11が取り付けられる 蓋体16と該蓋体16がねじ止めされる前記タンク14 と該タンク14内に取り外し可能に取り付けられるシー ルド板17とから成る3つのパーツから構成されてお り、洗浄メンテナンス時には、前記タンク14から薔体 16とシールド板17を取り外して、水洗いすることに より反応性生成物を洗浄する。

4

【0012】このように本発明では、前述したようにト 従来のような排気配管内への反応生成物の堆積を防止し ているため、当該反応性生成物により排気配管6内が閉 塞し、ドライポンプ4の排気ができずにドライポンプ4 が異常停止するといった不具合の発生が防止される。更 に、トラップ装置10内に仕切り板13を設けて、該仕 切り板13により排ガスをタンク14内で循環させるよ うにして、該排ガスがタンク14内に取り付けられたシ ールド板17の側壁部や該仕切り板13に接する面積を 多くすることで、トラップ装置10が配置されるだけの 【0013】また、製品処理中のボンプ停止により真空 状態が解除され、ドライエッチング装置内が大気に触れ るため、塵埃が入り、製品不良が発生することがなく。 この反応生成物による排気配管6の閉塞によるボンプ停 止を原因とする製品不良の発生が防止される。更に、洗 浄箇所がトラップ装置10内に限定されるため、従来の ように排気配管の広い範囲内に渡って洗浄作業を施す必 要が無く、洗浄メンテナンスが簡便になる。また、タン

ク14内にシールド板17を取り付けたことにより、部 【0014】また、異常停止によるドライボンプ4の故 隨の発生が防止される。

#### [0015]

【発明の効果】以上、本発明によればトラップ装置内に 反応性生成物を回収するようにし、従来のような排気配 管内への反応生成物の維積を防止しているため、当該反 応性生成物により排気配管内が閉塞し、ドライボンプの 排気ができずにドライボンプが異常停止するといった不 具合の発生を防止できる。

【0016】更に、トラップ装置内に仕切り板を設け て、該仕切り板により排ガスをタンク内で循環させるよ うにして、該排ガスがタンク内に取り付けられたシール ド板の側壁部や該仕切り板に接する面積を多くすること で、トラップ装置が配置されるだけの狭いスペースで、 冷却効果、堆積効果の向上が図れる。また、製品処理中 のボンプ停止により直等状態が解除され、ドライエッチ ング装置内が大気に触れるため、塵埃が入り、製品異常 が発生することがなく、この反応生成物による排気配管 の閉塞によるポンプ停止を原因とする製品異常の発生を

(4)

【0017】更に、洗浄箇所がトラップ装置内に限定されるため、 後来のように頻気配管の広い範囲内に渡って 洗浄作業を施す必要が無く、洗浄メンテナンス倍便に なると共に、タンク内にシールド板を取り付けたことに より、部分洗浄が可能となり、更にメンテナンス作業性 を向上できる。また、異常停止によるドライボンブの故 陳の発生を防止できる。

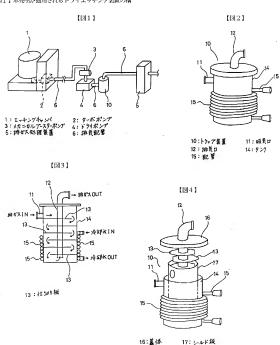
5

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明が適用されるドライエッチング装置の構 成例を示す図である。

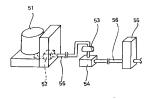
【図2】ドライエッチング装置のトラップ装置を示す斜 視図である。

【図3】ドライエッチング装置のトラップ装置を示す断 面図である。

【図4】トラップ装置の分解状態を示す図である。 【図5】従来のドライエッチング装置の構成例を示す図 である。







フロントページの続き

(72) 発明者 森山 剛 新潟県小千谷市千谷甲3000番地 新潟三洋 電子株式会社内